特許協力条約

今後の手続きについては、様式PCT/IPEA/416を参照すること。

PCT

特許性に関する国際予備報告(特許協力条約第二章)

(法第12条、法施行規則第56条) [PCT36条及びPCT規則70]

出願人又は代理人

国際出願番号

の書類記号 RXO3P10PCT

MAILED 13	OCT 2005
WIPO	PCT

国際出願番号 PCT/JP2004/008312	国際出願日 (日.月.年) 14.00	6.2004	優先日 (日.月.年)	18.06.	2003
国際特許分類(I P C)Int.Cl. ⁷ H01F1/053	1/08, 41/02				
出願人 (氏名又は名称) 独立行政法人科学技術振興機構					
この報告 は、PCT35 条に基づきこ 法施行規則第 57 条 (PCT36 条) の この国際予備審査報告は、この表紙を この報告には次の附属物件も添付され この報告には次の附属物件も添付され この報告には次の附属物件も添付され この報告には次の附属物件も添けされ この報告には次の対象の対象を記述される この報告には次の対象を記述される この報告には次の対象を記述される この報告には次の対象を記述される この報告には次の対象を記述される この報告には次の対象を記述される この報告には次の対象を記述される この報告には次の対象を記述される この報告には次の対象を記述される この報告を記述される この報述される この報述される	規定に使い 送付する。 含めて全部で <u>_</u> ている。			ర ం	
a. ▼ 附風書類は全部で	きとされた及び/又はこの CT規則 70.16 及び実施 たように、出願時におり 差替え用紙	神則第 607 号参照 ける国際出願の開示) その範囲を超え (492.7 th	た補正を含む	ものとこの
4. この国際予備審査報告は、次の内容を			·		
	告の基礎 又は産業上の利用可能性 欠如 規定する新規性、進歩性 及び説明 歌				1を裏付
国際予備審査の請求書を受理した日	· जिल्ह	子牌本木却ようか	A) 4 F		

国際予備審査報告を作成した日

特許庁審査官(権限のある職員)

菊地 聖子

03.10.2005

電話番号 03-3581-1101 内線 3565

5 R

3142

21. 01. 2005

日本国特許庁 (IPEA/JP)

郵便番号100-8915 東京都千代田区窟が関三丁目4番3号

名称及びあて先

第I概	報告の基礎			
				·
		下配に示す場合を除くほか		造とした。
Γ	この報告は、	語による翻訳文を	生磁とした。	•
	それは、次の目的で提出	出された翻訳文の曾語であ	ンる。	
ŗ	PCT規則12. 3及ひ	び23.1(b)にいう国際調査		
ŕ	PCT規則12.4にい PCT規則55.2マロ	いう国際公開 は55.3にいう国際予備審査	-	
•		•		
2. この た 差 替;	り報告は下記の出願書類 え用紙は、この報告にお「	iを基礎とした。 (法第6条 いて「出願時」とし、この	を(PCT14条)の規定に D報告に添付していない。	と基づく命令に応答するために提出され)
Г	出願時の国際出願告類			· .
₩.	明細費			
	第1-3,6-19	ページ、	. 出願時に提出されたもの	M
	第 <u>4,4/1,5,5</u>	5/1 ページ*.	21.01.2005	付けで国際予備薬を機関が必要したすの
-	第	ページ *		_ 付けで国際予備審査機関が受理したもの _ 付けで国際予備審査機関が受理したもの
V	請求の範囲			THE PERSON A NUMBER OF STREET OF STREET
	第2,3,5	項、	中間時に規用されたも	~
	匆	125 *	DCT10なの担合にも	tt at at above to you a
••	N1		: 21 01 2005	fold the second to the second
	第 <u>·</u>	一—————————————————————————————————————		_ 付けで国際予備審査機関が受理したもの _ 付けで国際予備審査機関が受理したもの
V		٠,		
	第1-6		中国中で祖中をかずず	_
	ж <u></u>	ページ/図*		ALIA-MININE WILLIAM STATE SAME SAME SAME SAME SAME SAME SAME SAM
	第	ページ/図*	<u> </u>	_ 付けで国際予備審査機関が受理したもの _ 付けで国際予備審査機関が受理したもの
Г	配列表又は関連するテ		•	- 1907、日本:個型工政党が文型したもの
•	配列表に関する補	ーフル 充概を参照すること。		
3. 「	補正により、下記の書類	類が削除された。	•	·
			•	
	「 明細書 「 請求の範囲	第		
	関面	界		項
	配列表(具体的に	記載すること)		ページ/図
		テーブル(具体的に記載す	「ること)	·
4.	この郵告は「補充棚に	ニュナンに との知生に		
2.	えてされたものと認めに	ドレにょうに、この _{牧豆に} られるので、その補正がさ	- 称付されかつ以下に示し (カカかったものレーアル	した補正が出願時における開示の範囲を超 ■成した。 (PCT規則 70.2(c))
	一 明細書	And the Control of the summer of	4いよん・フにもりこしてに	・成した。 (PCT規則 70.2(c))
	明細語 「請求の範囲	第		ページ
	図面	第	I	項
	配列表(具体的に計	記載すること)		ページ/図
	配列表に関連する ラ	テーブル(具体的に記載す	「ること)	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
-		-	•	
•				İ
± 4 ½		-		.)
* 4. r.	- 終ヨッる場合、その用剤	紙に"superseded"と記入	、されることがある。	
				, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

クロチェア おかり	for All Ath. Alfa the List
郑 V 伽	新規性、連歩性又は確常上の利用可能性についての社会 10 g /p c * / · ›
	新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての法第 12条 (PCT35条(2)) に定める見解、
	とかたびはけてかせない。
	それを返付ける文献及び説明

1	見解

新規性 (N)	請求の範囲 請求の範囲	1-5	有 無
進歩性(IS)	請求の範囲	1-5	
産業上の利用可能性(IA)	請求の範囲 請求の範囲	1-5	有

2. 文献及び説明 (PCT規則 70.7)

文献1: JP 62-74048 A (住友特殊金属株式会社) 1987.04.04,全文,第1図 (ファミリーなし)

文献2: JP 4-119604 A (富士電気化学株式会社)

1992.04.21,全文,第1-7図 (ファミリーなし)

文献3: JP 7-122414 A (いすゞ自動車株式会社)

1995.05.12,全文,第1-2図(ファミリーなし)

請求の範囲1-5

文献1には、Fe-B-R系永久磁石材料において、高保磁力を出現させる粒界相を焼結磁石体表面の結晶群上に、最適な厚みで粒界相を設けるために、厚み $15\,\mu\,m$ 以下のDy, Ho, Tbなどを薄膜層を形成し、熱処理する点が記載されている。

新たな文献 2 には、N d 2 F e 14 B を主相 1 とし、これをN d 1 ッチ相 2 や B 1 ッチ相 3 が取り囲んでいるニュークリエーション型磁石において、主相 1 を取り囲むN d 1 ッチ相 2 との界面が保磁力を発生させる点、焼結型N d 1 F e 1 B 系永久磁石バルク体に、1 D y や P 1 を含む組成物を平均膜 1 の 1

新たな文献 3 には、N d -F e -B 系アモルファス急冷リボン粉末において、リボン状の非晶質粉末間のD y 拡散層の幅に応じて保磁力が変化する点、及び、保磁力は拡散層の幅が 0. $4\sim0$. 8 μ m o 場合に大きくなり、この範囲の拡散層を得るために C o -D y 合金粉末をアモルファス急冷リボン粉末に対して $1\sim2$ 0 w t %の範囲で添加する点が記載されている。すなわち、D y 成分を $1\sim2$ 0 w t %程度添加し

補充概

いずれかの棚の大きさが足りない場合

第 V.2 棡の続き

て、Dy拡散層を髙保磁力が得られる厚みとすることが記載されている。

そして、Dy, Tbが表面に拡散したR-Fe-B系永久磁石として、文献 1 に記載された、高保磁力を出現させる粒界相を設けるために、Dy, Ho, Tbなどの薄膜層を形成して熱処理する際に、文献 2 に記載された、 $400\sim900$ で熱処理してDy 等によりNd リッチ相の欠け部分を補うこと、及び、文献 3 に記載された、Dy成分を $1\sim20$ w t %程度添加し、高保磁力が得られる厚みのDy 拡散層を得る点は、当該技術分野の専門家にとっては容易に想到し得たことである。

なお、文献1に記載された発明に、文献2、3に記載された発明を適用したものは、本願の明細書の実施例より、本願発明と同様の磁石材料及び製造方法を適用していることから、本願発明と同様の磁気特性を有するものと認められる。

ロン以下の厚さの均一で薄いNdリッチ粒界相が取り囲んでいる。核発生型の磁石では、減磁界(demagnetizing field)が加わったときの逆磁区の発生をいかに抑止するかが保磁力の大小を決めるため、逆磁区の核となりやすい不純物や不均一な組織を排除する必要がある。例えば、文献 D.Givord et al., J.Appl.Phys., 60 (1986) 3263 において、逆磁区は磁石内部の結晶粒界の乱れと磁石表面の酸化や機械的損傷によって発生し、特に表面の影響が大きいことが指摘されている。また、実際に焼結磁石を機械加工によって裁断して磁石厚さをおよそ1 mm以下にした場合に、保磁力が著しく低下することが良く知られている。

[0015] そこで、本発明では、希少なDy等の希土類元素含有量を節減しても高保磁力、又は高残留磁束密度が得られることを特徴とする高性能な希土類磁石を提供することを目的とする。

課題を解決するための手段

- [0016] 焼結磁石の磁気特性の改良には最終製品を得るために所定の形状寸法とするため機械加工などを済ませた磁石に対して、特性向上の技術を付加するのが合理的な解決法であり、既に、本発明者らは、最終磁石製品の表面に希土類金属を成膜して拡散することにより、磁気特性を向上させる技術に関する発明を特許出願した(特願2003-96866号)。
- [0017] 本発明者らは、さらに技術内容を詳細に吟味した結果、従来の焼結磁石では得られない保磁力を、Dy等のわずかな含有量で実現できるか、又は従来と同等のDy含有量においては残留磁束密度を向上させることができる手段を見出した。この手段により、残留磁束密度の低下を抑制して最大エネルギー積の大幅な向上を図ることができた。
- [0018] 本発明者らは、Nd-Fe-B系希土類磁石の保磁力機構を基に、焼結磁石の結晶 組織と磁石に含有されるDy等の元素の役割について詳細に実験調査を重ねた結 果、Dy等の希土類金属を磁石内部側に薄く、表面側に濃く分布させることにより、磁 石中のDy等の希土類金属を有効活用した高性能希土類磁石の開発に成功した。
- [0019] すなわち、本発明は(1)主結晶の間に希土類元素リッチな粒界層を有する磁石 表面からのM元素(但し、Mは、Pr, Dy, Tb, Hoから選ばれる希土類元素の一種又

4/1

日本国特許庁 21.1.2005

は二種以上)の拡散により希土類元素リッチ相と反応した、M元素が富化した結 晶粒 界層を有し、保磁力Hcj と磁石全体に占めるM元素含有量が下記の式で表されることを特徴とする、希土類一鉄一ホウ素系磁石、である。

[0020] Hcj≥ 1+0. 2×M (ただし、0. 05≤M≤10) ただし、Hcj:保磁力、単位 (MA/m)、M:磁石全体に占めるM元素含有量 (質量 %)

また、本発明は、(2) 残留磁束密度Br と保磁力Hcj が下記の式で表されることを特徴とする、上記(1)の希土類一鉄一ホウ素系磁石、である。

[0021] Br≥1.68-0.17×Hcj ただし、Br:残留磁束密度、単位(T)

また、本発明は、(3) 希土類一鉄一ホウ素系磁石が、粉末成形と焼結法によって製作される磁石、又は粉末成形と熱間塑性加工によって製作される磁石、であって、主結晶の間に希土類元素リッチな粒界層を有する磁石であることを特徴とする上記(1)又は(2)の希土類一鉄一ホウ素系磁石、である。

- [0022] さらに、本発明は、(4) 主結晶の間に希土類元素リッチな粒界層を有する磁石を減圧 槽内に支持し、該減圧槽内で物理的手法によって蒸気又は微粒子化したM元素(但し、Mは、Pr, Dy, Tb, Hoから選ばれる希土類元素の一種又は二種以上)又はM元素を含む合金を、該磁石の表面の全部又は一部に飛来させて成膜し、かつ該磁石の最表面に露出している結晶粒子の半径に相当する深さ以上に該磁石内部にM元素を磁石表面から拡散浸透させることによって、希土類元素リッチ相と反応させ、M元素が富化された結晶粒界層を形成することを特徴とする上記(1)ないし(3)のいずれかの希土類一鉄一ホウ素系磁石の製造方法、である。
- [0023] また、本発明は、(5)結晶粒界層のM元素の濃度を磁石の表面側ほど高濃度に富化させることを特徴とする上記(4)の希土類一鉄一ホウ素系磁石の製造方法、である
- [0024] 本発明では、M元素(但し、Mは、Pr, Dy, Tb, Hoから選ばれる希土類元素の一種又は二種以上)を表面に成膜して拡散することにより、M元素を結晶粒界部に富化させることによりDy等の希土類金属を磁石内部側に薄く、表面側に濃く分布させることができる。

5/1

日本国特許庁

21. 1. 200!

[0025] Nd-Fe-B系焼結磁石において、大きな保磁力を得るためには異方性磁界の大

請求の範囲

[1] (補正後)主結晶の間に希土類元素リッチな粒界層を有する磁石表面からのM元素(但し、Mは、Pr, Dy, Tb, Hoから選ばれる希土類元素の一種又は二種以上)の拡散により希土類元素リッチ相と反応した、M元素が富化した結晶粒界層を有し、保磁力Hcjと磁石全体に占めるM元素含有量が下記の式で表されることを特徴とする、希土類一鉄一ホウ素系磁石。

Hcj≥1+0. 2×M(ただし、0. 05≤M≤10)

ただし、Hej:保磁力、単位(MA/m)、M:磁石全体に占めるM元素含有量(質量%)

[2] 残留磁束密度Brと保磁力Hcjが下記の式で表されることを特徴とする、請求項1記載の希土類一鉄一ホウ素系磁石。

Br≧1. 68-0. 17×Hcj

ただし、Br:残留磁束密度、単位(T)

- [3] 希土類一鉄一ホウ素系磁石が、粉末成形と焼結法によって製作される磁石、又は 粉末成形と熱間塑性加工によって製作される磁石、であって、主結晶の間に希土類 元素リッチな粒界層を有する磁石であることを特徴とする請求項1又は2記載の希土 類一鉄一ホウ素系磁石。
- [4] (補正後)主結晶の間に希土類元素リッチな粒界層を有する磁石を減圧槽内に支持し、該減圧槽内で物理的手法によって蒸気又は微粒子化したM元素(但し、Mは、Pr, Dy, Tb, Hoから選ばれる希土類元素の一種又は二種以上)又はM元素を含む合金を、該磁石の表面の全部又は一部に飛来させて成膜し、かつ該磁石の最表面に露出している結晶粒子の半径に相当する深さ以上に該磁石内部にM元素を磁石表面から拡散浸透させることによって、希土類元素リッチ相と反応させ、M元素が富化された結晶粒界層を形成することを特徴とする請求項1ないし3のいずれかに記載の希土類一鉄一ホウ素系磁石の製造方法。
- [5] 結晶粒界層のM元素の濃度を磁石の表面側ほど高濃度に富化させることを特徴と する請求項4記載の希土類一鉄ーホウ素系磁石の製造方法。